

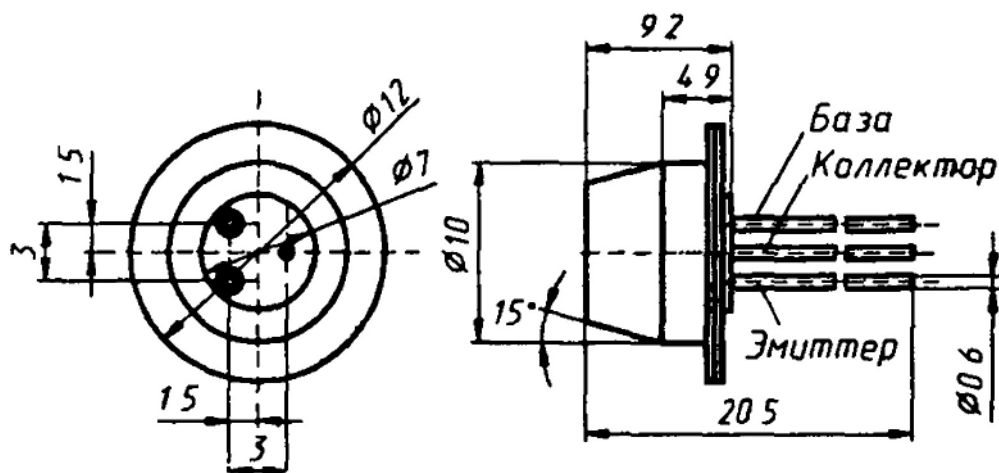
**1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е,
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г,
ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю**

Транзисторы германиевые сплавные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в переключающих устройствах, выходных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях и стабилизаторах постоянного тока. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 4 г.

Изготовитель — завод полупроводниковых приборов, г. Запорожье.

1Т403(А-И), ГТ403(А-Ю)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 1$ В, $I_3 = 0,45$ А для 1Т403Е, ГТ403Е, 1Т403И, ГТ403И, не менее 30

Изменение статического коэффициента передачи тока в схеме ОЭ 1Т403Е, 1Т403И

при $U_{КБ} = 1$ В, $I_3 = 0,45$ А, не более:

при $T = +70$ °С $\pm 30\%$

при $T = -60$ °С -40%

Граничная частота коэффициента передачи

тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 0,1$ А,

не менее 8 кГц

Коэффициент передачи тока в режиме малого

сигнала при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 0,1$ А,

$f = 50...300$ Гц:

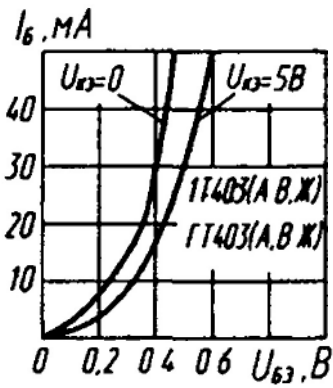
1Т403А, 1Т403В, 1Т403Ж, ГТ403А, ГТ403В, ГТ403Ж	20...60
1Т403Б, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403Б, ГТ403Г, ГТ403Д	50...150
ГТ403Ю	30...60
Изменение коэффициента передачи тока в ре- жиме малого сигнала 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Ж при $U_{кб} = 5$ В, $I_3 = 0,1$ А, $f = 50...300$ Гц, не более:	
при $T = +70$ °С	±30%
при $T = -60$ °С	-50%
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 0,5$ А, $I_b = 0,05$ А, не более	0,5 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 0,5$ А, $I_b = 0,05$ А, не более	0,8 В
«Плавающее» напряжение эмиттер—база при $U_{кб} = 45$ В для 1Т403А, 1Т403Б, при $U_{кб} = 60$ В для 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, при $U_{кб} = 80$ В для 1Т403Ж, 1Т403И, $T = +70$ °С, не более	0,3 В
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кб, макс}$, не более:	
$T = +25$ °С:	
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	50 мкА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	70 мкА
$T = +70$ °С	800 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{бэ} = 20$ В для 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Е, ГТ403Ю; $U_{бэ} = 30$ В для 1Т403Д, ГТ403Д, не более:	
$T = +25$ °С:	
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	50 мкА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	70 мкА
$T = +70$ °С	80 мкА
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{кэ} = U_{кэ, макс}$:	
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д,	

1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	5 мА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	6 мА

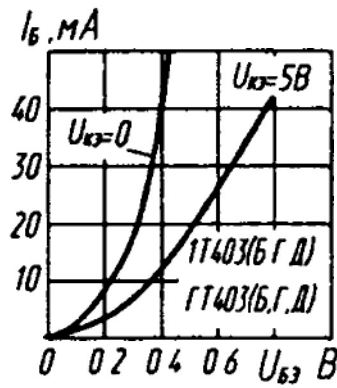
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:	
1Т403А, 1Т403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю	30 В
1Т403В, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Е, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403Г, ГТ403Д	45 В
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	60 В
Постоянное напряжение коллектор—база:	
1Т403А, 1Т403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю	45 В
1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е	60 В
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	80 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	20 В
1Т403Д, ГТ403Д	30 В
Постоянный ток коллектора	1,25 А
Постоянный ток базы	0,4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора:	
с теплоотводом	$(85 - T_K) / R_{T(p-k)}$, Вт
без теплоотвода	$(85 - T_K) / R_{T(p-c)}$, Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	15 °С/Вт
для 1Т403В, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Е	12 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход—среда	100 °С/Вт
Температура р-п перехода	+85 °С
Температура окружающей среды:	
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, 1Т403Ж, 1Т403И	-60...+70 °С
ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю	-55...+70 °С

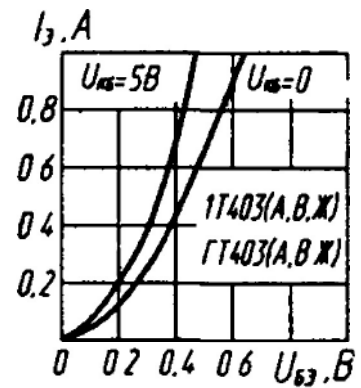
Изгиб и пайка транзисторов допускается не ближе 3 мм от корпуса с температурой жала паяльника не более +260 °С в течение 3 с и групповым или механизированным способом при температуре припоя не более +260 °С в течение 5 с.



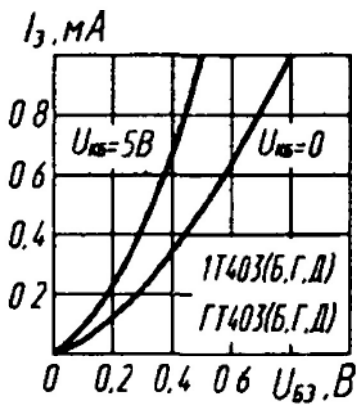
Входные характеристики



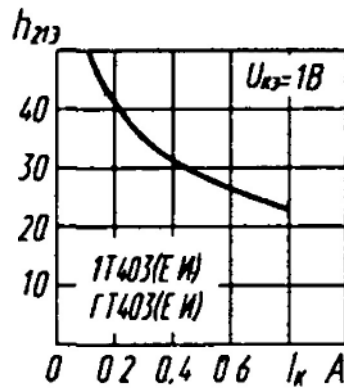
Входные характеристики



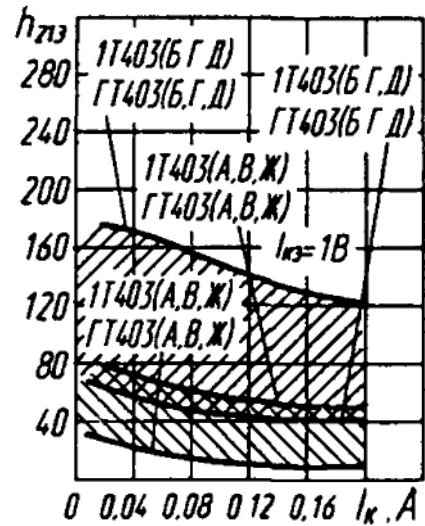
Зависимость тока эмиттера от напряжения база—эмиттер



Зависимость тока эмиттера от напряжения база—эмиттер



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора